

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5980

SJ 50033/114—96

半导体光电子器件
GD3283Y 型位敏探测器
详细规范

Semiconductor optoelectronic devices
Detail specification for type GD3283Y
position sensitive detector

1996-08-30 发布

1997-01-01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

中华人民共和国电子行业军用标准

半导体光电子器件 GD 3283Y 型位敏探测器详细规范

SJ 50033/114-96

Semiconductor optoelectronic devices
Detail specification for type GD3283Y
position sensitive detector

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 GD3283Y 型位敏探测器(以下简称器件)的详细要求。

1.2 适用范围

本规范适用于器件的研制、生产和采购。

1.3 分类

1.3.1 器件等级

本规范所提供的器件保证等级按 GJB 33《半导体分立器件总规范》的规定,从低到高分为普军级(GP)和特军级(GT)两级。

2 引用文件

GB 11499-89	半导体分立器件文字符号
GJB 33-85	半导体分立器件总规范
GJB 128-86	半导体分立器件试验方法
GJB 597-88	微电路总规范
SJ 2354-83	PIN 雪崩光电二极管测试方法
SJ/Z 9014.2-87	半导体器件 分立器件和集成电路第 5 部分:光电子器件

3 要求

3.1 详细要求

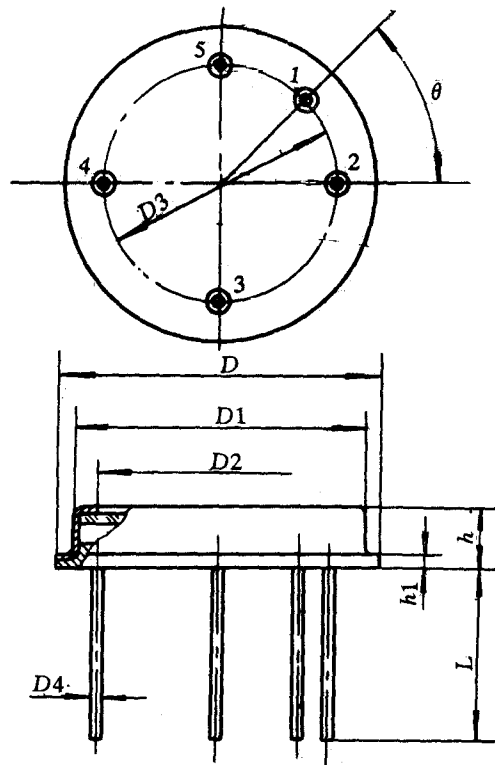
各条要求应符合 GJB 33 和本规范的规定。

3.2 设计、结构和外形尺寸

器件的设计和外形尺寸应符合 GJB 33 和本规范的规定,结构应采用二维平面在分割成 X_1 、 X_2 、 Y_1 、 Y_2 对称四电极为直角坐标的 PIN 结构。也可按合同要求提供不同于图 1 的外形尺寸(见 6.2 条)。

中华人民共和国电子工业部 1996-08-30 发布

1997-01-01 实施



mm		
尺寸符号	最小值	最大值
D	26.0	26.6
D1	21.4	21.8
D2	19.1	20.6
D3	18.8	19.2
D4	0.1	0.6
h	4.6	5.2
h1	0.6	0.8
L	15	20
θ	43	47

图 1 外形尺寸

3.2.1 器件芯片材料

器件芯片材料为硅。

3.2.2 引出端排列

管脚	1	2	3	4	5
接线	共用电极	X_2	Y_1	X_1	Y_2

3.2.3 封装形式

全密封金属管壳平面玻璃窗口。

3.2.4 引线长度

可按合同的规定(见 6.2 条)提供引线长度不同于图 1 规定的器件。

3.3 引线材料及涂层

引线材料为可伐合金,引线涂层应镀金。也可按合同要求(见 6.2 条)选择涂层。

3.4 最大额定值和主要光电特性

3.4.1 最大额定值

T_{amb} ℃	T_{stg} ℃	$T_{stg}^{(1)}$ ℃	I_F mA	V_R V	P_{tot} mW
-45~85	-55~100	260	10	20	30

注:1)最长焊接时间不超过 5s,至管壳的最短距离 5mm。

3.4.2 主要光电特性($T_{amb} = 25^\circ\text{C}$)